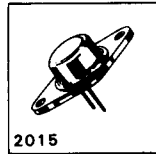


# 2SD315

## 2SB509

低周波電力増幅用



2015

Mesa Type Silicon Transistor  
For AF Power Amplifier Use

★A complementary pair.

⊖ C444

- ・ 20~30 W の低周波パワーアンプ出力段用に最適。これらはコンプリメンタリペアを組むことができる。
- ( ) 内は 2SB509 の場合を示す。

絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings/ $T_a=25^\circ\text{C}$		unit	
コレクタ・ベース電圧	$V_{CB0}$	(-)60	V
コレクタ・エミッタ電圧	$V_{CE0}$	(-)60	V
エミッタ・ベース電圧	$V_{EB0}$	(-)5	V
コレクタ電流	$I_C$	(-)4	A
ピークコレクタ電流	$i_{cp}$	(-)10	A
コレクタ損失	$P_C$	$T_c=25^\circ\text{C}$	35 W
接合部温度	$T_j$		150 $^\circ\text{C}$
保存周囲温度	$T_{stg}$		-40~+150 $^\circ\text{C}$

電気的特性 Electrical Characteristics/ $T_a=25^\circ\text{C}$		min	typ	max	unit
コレクタしゃ断電流	$I_{CBO}$ $V_{CB}=(-)20\text{V}, I_E=0$			(-)0.1	mA
エミッタしゃ断電流	$I_{EBO}$ $V_{EB}=(-)4\text{V}, I_C=0$			(-)1.0	mA
二次降伏電圧	$V_{S/B}$ $I_C=(-)0.5\text{A}, t=1\text{sec}$	(-)60			V
直流電流増幅率	※ $h_{FE}(1)$ $V_{CE}=(-)2\text{V}, I_C=(-)1\text{A}$	※40		※320	
	$h_{FE}(2)$ $V_{CE}=(-)2\text{V}, I_C=(-)0.1\text{A}$	40			
利得帯域幅積	$f_T$ $V_{CE}=(-)5\text{V}, I_C=(-)0.5\text{A}$			8	MHz
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$ $I_C=(-)2\text{A}, I_E=(-)0.2\text{A}$	(-)0.4	(-)1.0		V
ベース・エミッタ電圧	$V_{BE}$ $I_C=(-)1\text{A}, V_{CE}=(-)2\text{V}$		(-)1.5		V

※ 2SB509, 2SD315 は 2V 1A  $h_{FE}$  により次のように分類している。

40	C	80	60	D	120	100	E	200	160	F	320
----	---	----	----	---	-----	-----	---	-----	-----	---	-----

外形図 2015  
(unit: mm)

